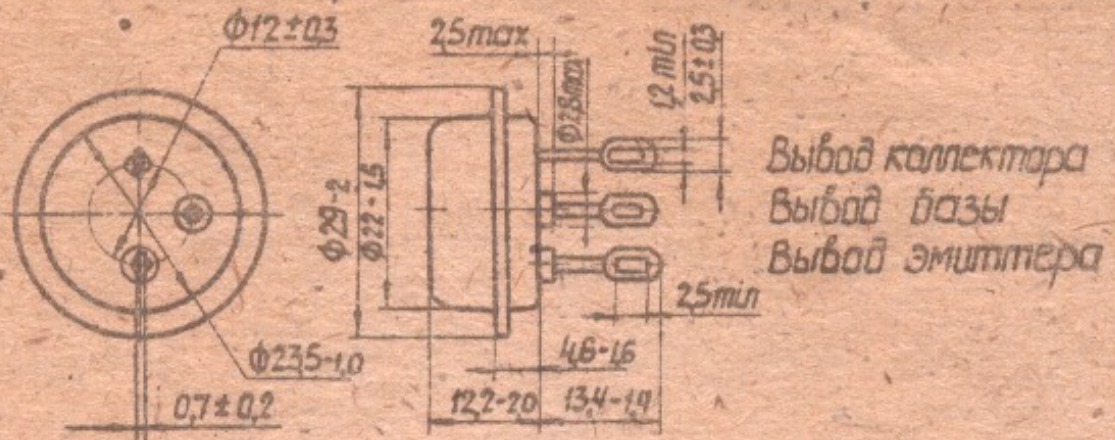


# Этикетка



Транзисторы типов  
1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В  
соответствуют  
требованиям технических  
условий 3.365.009ТУ



Масса не более 28 г

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт.  
транзисторов

Золото 116.6 (мг)

серебро 90055.0 (мг)

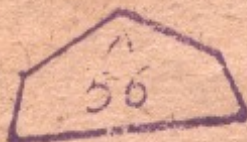


# Основные электрические параметры

при  $t_{окр.} = 20 \pm 5^{\circ}C$ .

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквен- ное обозна- чение	Норма					
		1Т806А		1Т806Б		1Т806В	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (на границе насыщения) ( $I_k = 10A$ )	$h_{21э}$	10	100	10	100	10	100
Обратный ток коллектор-эмиттер, мА ( $U_{кэ} = -75V$ для 1Т806А) ( $U_{кэ} = -100V$ для 1Т806Б) ( $U_{кэ} = -120V$ для 1Т806В) ( $U_{эб} = -1V$ для 1Т806А, Б, В)	$I_{кэх}$	—	12	—	12	—	12
Обратный ток эмиттера, мА ( $U_{эб} = -2V$ )	$I_{эб0}$	—	5	—	5	—	5
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В ( $I_k = 20A, I_b = 2A$ )	$U_{кэнас}$	—	0,6	—	0,6	—	0,6
Напряжение насыщения база-эмиттер, В ( $I_k = 20A, I_b = 2A$ )	$U_{бэнас}$	—	0,8	—	0,8	—	0,8
Граничное напряжение, В ( $I_э = 3A$ )	$U_{кэогр}$	40	—	65	—	80	—

Штамп ОТК



Штамп представителя-заказчика

